

## 大阪大学 ナノテクノロジー設備供用拠点 利用規程

(平成24年 9月 10日制定 管理運営委員会)

(平成25年 4月 8日改定 管理運営委員会)

(平成26年 3月 1日改定 管理運営委員会)

(平成27年 6月 11日改定 管理運営委員会)

(平成28年 3月 7日改定 管理運営委員会)

### <趣旨>

第1条 この規程は、大阪大学内に設置されたナノテクノロジー設備供用拠点（以下「当拠点」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

### <目的>

第2条 当拠点が設置供用する装置及び実験室等（以下、装置群等という。）のうち、別表に定める微細加工プラットフォーム管理の装置群等（以下「加工群」という。）、分子・物質合成プラットフォーム管理の装置群等（以下、「合成群」という。）、及び微細構造解析プラットフォーム管理の装置群等（以下、「解析群」という。）について、ナノテクノロジー・ナノサイエンスを基盤とする最先端の研究・開発に挑む学内外の利用者（産学官の研究者）に対して、高度な技術支援を行うとともに、利用機会を提供する。

2 別表の装置群等については、適宜変更することがある。

### <利用日>

第3条 装置群等の利用日は、次の各号に掲げる以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、拠点長（ナノテクノロジー設備供用拠点設置要項第4条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）が特に必要と認めたときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。

### <利用時間>

第4条 装置群等の利用時間は、午前9時00分から午後5時00分とする。

2 前項の規定にかかわらず、拠点長が特に必要と認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することがある。

### <利用者の資格>

第5条 装置群等を利用することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

- (1) 本学の教職員及び学生
- (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
- (3) 企業等の法人に所属し、研究開発に従事する者
- (4) その他、拠点長が特に必要と認めた者

#### <利用の申込>

第6条 装置群等を利用しようとする者は、所定の申込書を拠点事務室（ナノテクノロジー設備供用拠点設置要項第6条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）に提出し、管理運営委員会（ナノテクノロジー設備供用拠点設置要項第5条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）にてその許可を受けなければならない。

2 拠点長は、前項により利用を許可した者に対して、その旨を30日以内に通知するものとする。

3 拠点長は、第1項の許可に際し必要と認めるときは、当該利用について必要な条件を付すものとする。

4 第1項における許可を受けられなかった者は、その異議を申し立てることはできない。また、許可を受けられなかったことによる不利益に対して、当拠点は責を負わない。

5 第1項の許可を受けた者は、「加工群」「合成群」「解析群」のそれぞれの利用に関する責任者（以下「利用責任者」という。）となる。

6 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、利用日時を変更する場合は、速やかに拠点事務室に申し出て、その許可を受けなければならない。

#### <利用の区分>

第7条 装置群等の利用区分として、委託区分と自主区分とを設け、次の各号の一に該当する区分を自主区分とする。

- (1) <削除>
- (2) <削除>
- (1) 当拠点の運営関係者の利用の場合
- (2) その他、管理運営委員会が特に必要と認めた場合

#### <利用の形態>

第8条 装置群等の利用形態として、次の各号を設ける。

- (1) 機器利用
- (2) 技術補助
- (3) 技術代行
- (4) 共同研究
- (5) 技術相談

<利用責任者の責務>

第9条 利用責任者は、装置群等の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に利用しなければならない。

- (1) 利用を許可された装置群等について、拠点長が定める装置管理者等による十分な教育を受けること。
- (2) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等の保全に努めること。
- (3) 利用を許可された目的以外に使用しないこと。
- (4) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等を他の者に一部又は全部を転貸しないこと。
- (5) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、拠点長が許可する場合を除く。
- (6) その他拠点長が定め、又は指示する事項

<利用の許可の取消等>

第10条 拠点長は、次の各号の一に該当する場合、装置群等の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

- (1) 利用責任者が、この内規に違反し、又は違反するおそれがあると拠点長が認めるとき
- (2) 利用責任者が、所定の申込書に虚偽の記載をしたとき
- (3) 本学において、管理上の事由が生じたとき

<報告義務>

第11条 利用責任者は、拠点長からその利用にかかる事項について報告を求められた場合は、それに応じなければならない。

<利用負担金等>

第12条 利用責任者は、本学の指定する方法により、利用負担金を納付しなければならない。

- 2 利用負担金の額は別規程に定めるところによる。
- 3 秘密保持契約の締結を要する技術相談に関しては、5,000円/時間を上限とする。
- 4 一旦納付された利用負担金は、返還しない。ただし、本学の都合により利用の許可を取り消し又は利用を中止した場合は、利用負担金の全部又は一部を返還する。

<消耗品等>

第13条 装置群等で使用する消耗品及び材料等は原則として利用責任者が準備し、負担するものとする。

- 2 当拠点にある消耗品及び材料等を使用した場合は、その実費を負担するものとする。
- 3 利用責任者が準備し、負担する材料については、本学の諸規程に従い拠点長が使用を認めたもののみとする。

<損害賠償>

第14条 利用責任者は、本人又は当該利用にかかる関係者がその責に帰すべき事由により装置群等及び設備又は物品を滅失、破損または汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

<原状回復>

第15条 利用責任者は、当該装置群等の利用を終えたとき（第8条の規定により利用許可の取り消し、又は利用を中止した場合を含む。）は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、拠点長が特に認めたときは、この限りではない。

2 利用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、拠点長は利用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合利用責任者は、拠点長に異議を申し立てることができない。

<装置群等利用の明記>

第16条 利用責任者は、当拠点を利用して行った研究成果を論文、特許等により公表するときは所定の成果利用届を提出するものとし、当該論文等に次に掲げる文を明記するものとする。

(1) 和文：本成果は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業（大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点）[課題番号](\*)の支援を受けて実施されました。

(2) 英文：A part of this work was supported by “Nanotechnology Platform Project (Nanotechnology Open Facilities in Osaka University)” of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan [No.:(\*)].

(\*) 課題番号は本拠点より通知する。

<安全衛生管理>

第17条 利用責任者及び装置群等の利用にかかる関係者は、当該拠点における安全衛生管理について、関係する法令及び本学の諸規程（以下「法令等」という。）を遵守するとともに、法令等に基づき拠点長が行う指示に従わなければならない。

2 利用責任者は、騒音、振動、水質汚濁及び悪臭等の環境問題が発生しないよう、予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、利用責任者の責任において速やかに解決のための措置を講じなければならない。

3 前項の問題が解決されない場合は、拠点長は、装置群等の利用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

<その他>

第18条 この内規に定めるもののほか、装置群等の利用に関し必要な事項は、拠点長が別途定める。

附 則

この利用規程は、平成24年 9月 1日から施行する。

なお、この利用規程は、当分の間、大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点のうち、加工群及び合成群にかかる利用規程として運用するものとし、本利用規程のうち解析群にかかる条項について、附則別表に掲げる通り読み替える。また別表および「運営管理者が別途定める料金」については、それぞれ解析群を削除されたものと見做して運用する。解析群にかかる利用規程については「微細構造解析プラットフォームの利用規程」を適用する。

別表

| 加工群  | 合成群                        | 解析群                                    |
|--|----------------------------|--|
| ● 超高精細電子ビームリソグラフィ装置                            | ● 人工超格子薄膜形成システム (PLD)      | ● 日立製超高压電子顕微鏡(H-3000)                  |
| ● 高精細電子線リソグラフィ装置                               | ● 有機薄膜形成装置                 | ● 日立製FEG付透過型電子顕微鏡(HF-2000)             |
| ● 電子ビームリソグラフィ装置                                | ● 環境制御型走査型プローブ顕微鏡システム      | ● 日立製透過型電子顕微鏡(H-800)                   |
| ● 収束イオンビーム誘起化学蒸着装置                             | ● 薄膜X線回折装置                 | ● 日立製透過型電子顕微鏡(H-7500)                  |
| ● 集束イオンビーム装置                                   | ● 赤外・テラヘルツ時間分解分光装置         | ● 日立製透過型電子顕微鏡(H-7500)                  |
| ● リアクティブイオンエッチング装置<br>(RIE-10NR-NP, RIE-10NOU) | ● フーリエ変換赤外分光光度計            | ● 高分子-生物系電子顕微鏡用試料作製装置群                 |
| ● 絶縁膜成膜用RFスパッタリング装置                            | ● ナノ粒子解析装置<br>(ゼータサイザー)    | ● ミクロトーム<br>(Reichert Jung Ultracut E) |
| ● 金属成膜用スパッタリング装置                               | ● 位相変調型分光エリプソメーター          | ● 材料系電子顕微鏡用試料作製装置群                     |
| ● 深掘エッチング装置                                    | ● 高周波プラズマスパッタリング薄膜形成装置     | ● イオンミリング装置<br>(Gatan PIPS Model 651)  |
| ● ナノ薄膜形成システム                                   | ● RFスパッタ装置                 | ● FEI製透過型電子顕微鏡(Titan Krios)            |
| ● マスクアライナー                                     | ● 高温熱処理装置<br>(セラミックス電気管状炉) |  |
| ● LED 描画システム                                   | ● 紫外可視分光光度計                |  |
| ● イオンシャワーエッチング装置                               | ● 反応性イオンエッチング装置            |  |
| ● ナノインプリント装置                                   | ● ナノ薄膜構造解析装置               |  |
| ● 高精細集束イオンビー                                   | ● ナノ薄膜物性解析シス               |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ム装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 多元 DC/RF スパッタ装置</li> </ul> | <p>テム</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 二次イオン質量分析ナノデバイス加工システム</li> <li>● 接触式膜厚測定器</li> <li>● イオン化エネルギー測定装置</li> <li>● レーザーラマン顕微鏡</li> <li>● 電流密度測定装置</li> </ul> |  |
|--|--|--|

附則別表

| 条項         | 読み替え後   |
|------------|---|
| 第2条        | <p>当拠点が設置供用する装置及び実験室等（以下、装置群等という。）のうち、別表に定める微細加工プラットフォーム管理の装置群等（以下「加工群」という。）及び分子・物質合成プラットフォーム管理の装置群等（以下、「合成群」という。）について、ナノテクノロジー・ナノサイエンスを基盤とする最先端の研究・開発に挑む学内外の利用者（産学官の研究者）に対して、高度な技術支援を行うとともに、利用機会を提供する。</p> |
| 第6条<br>第4項 | <p>第1項の許可を受けた者は、「加工群」「合成群」のそれぞれの利用に関する責任者（以下「利用責任者」という。）となる。</p>  |